






	<h2 style="color: #E67E22;">FQD3N60TM</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQD3N60TM</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 2.4A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQD3N60TM.pdf</a> <a href="#">2.FQD3N60TM.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD3N60TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 2.4A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	5000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 2.4A (Tc) 2.5W (Ta), 50W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.6 Ohm @ 1.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	450pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD3N60TM ist neu im Original, Suche FQD3N60TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD3N60TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD3N60TM: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD3P20TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 2.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD3N60TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD3P20TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 2.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD3P50</b> FAIRCHI FQD3P50 FAIRCHI</p>
 <p><b>FQD3P20TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 2.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD3N60TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD3N60TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD3N60CTM-WS</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.4A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD30N06TF_F080	↔ FQD30N06TF_F080	⇒ FQD30N06TM	D FQD30N06TM	⇒ FQD30P06
⊕ FQD3N25T	⊗ FQD3N30TF	D FQD3N30TF	⇒ FQD3N30TM	⇒ FQD3N30TM
⊗ FQD3N40TM	⊕ FQD3N40TM	⊗ FQD3N50C	↔ FQD3N50C/CS	⇒ FQD3N50CTF
D FQD3N50CTF	⊗ FQD3N50CTM	⊕ FQD3N50CTM	⊗ FQD3N60C	⇒ FQD3N60CS
⇒ FQD3N60CTF	↔ FQD3N60CTM	⊗ FQD3N60CTM_WS	⊕ FQD3N60TF	⇒ FQD3N60TF
↔ FQD3N60TM	⇒ FQD3P20TF	D FQD3P20TF	⊗ FQD3P50TF	⊕ FQD3P50TF
⊗ FQD3P50TM	D FQD3P50TM	⇒ FQD4N20L	↔ FQD4N20LTF	⇒ FQD4N20LTF
⊕ FQD4N20TF	⊗ FQD4N20TF	↔ FQD4N20TM	⇒ FQD4N20TM	⇒ FQD4N25TM
⊗ FQD4N25TM	⊕ FQD4N50S	⊗ FQD4N50T	D FQD4N50TF	⇒ FQD4N50TF
↔ FQD4N50TM	⊗ FQD4N50TM	⊕ FQD4N60C	⊗ FQD4N60CTM	⇒ FQD4N65C

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited